# Процессы переноса заряда в ион-радикальных молекулярных проводниках $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>x</sub>Cl<sub>1-x</sub>: сверхпроводнике (x = 0.9) и проводнике с переходом металл-диэлектрик (x = 0)

© Р.М. Власова\*, Н.В. Дричко\*.\*\*, Б.В. Петров\*, В.Н. Семкин\*, D. Faltermeier\*\*, J. Barz\*\*, M. Dumm\*\*, M. Dressel\*\*, C. Mezier\*\*\*, P. Batail\*\*\*

 \* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
 \*\* Physikalisches Institut, Universität Stuttgart, Stuttgart, Germany
 \*\*\* Laboratoire CIMI, FRE 2447 CNRS–Universite d'Angers, Batiment K, UFR Sciences, Angers, France
 E-mail: rema.vlasova@mail.ioffe.ru

### (Поступила в Редакцию 9 октября 2008 г.)

Представлены спектральные оптические исследования в диапазоне  $50-6000 \text{ cm}^{-1}$  (6 meV-0.74 eV) органических низкоразмерных молекулярных проводников  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>x</sub>Cl<sub>1-x</sub> c x = 0.9 (сверхпроводник с  $T_c = 11.3 \text{ K}$ ) и x = 0 (металл с переходом металл/диэлектрик при T < 50 K) при температурах 300-20 K. Проведен количественный анализ спектров оптической проводимости в рамках предложенной авторами модели, предполагающей участие в переносе заряда двух типов носителей: локализованных на кластерах (димерах и тетрамерах молекул BEDT-TTF) электронов (дырок) и квазисвободных носителей заряда, с использованием "кластерной" тетрамерной модели, основанной на гамильтониане Хаббарда для коррелированных электронов, и модели Друде для квазисвободных носителей заряда. Определены физические параметры модели: энергия кулоновского отталкивания двух электронов (дырок) на одной молекуле, интегралы переноса между молекулами внутри димера и между димерами, константы электронно-колебательного взаимодействия. Дано объяснение анизотропии спектров в проводящей плоскости. Сделан вывод о том, что с внутримолекулярными колебаниями взаимодействуют только локализованные на кластерах электроны.

Работа поддержана программами ОФН РАН, НШ-2184.2008.2 и DFG.

PACS: 74.70.Kn, 78.20.Bh

# 1. Введение

Представленные в работе соединения вызывают в последнее время большой интерес исследователей, так как они относятся к сильно коррелированным электронным системам с необычными электронными свойствами, основным состоянием у которых могут быть конкурирующие моттовский изолятор, магнитоупорядоченное или сверхпроводящее состояние в зависимости от ширины и заполнения зоны проводимости и электронных взаимодействий. Исследования таких состояний интенсивно проводятся также для окислов переходных металлов и высокотемпературных сверхпроводников и представляют собой новую активно развивающиюся область физики твердого тела [1–3].

Значительный интерес к исследуемым молекулярным проводникам вызывают также их необычные электронфононные свойства, обусловленные взаимодействием электронной системы с внутримолекулярными колебаниями. Для  $\kappa$ -фазы проявление таких взаимодействий было обнаружено в оптических спектрах в работах [4–8] в виде интенсивных особенностей в ИК-области, расположенных вблизи частот полносимметричных внутримолекулярных колебаний ( $A_g$ -BMK) молекулы BEDT–TTF, которые обычно оптически неактивны в ИК-спектрах и проявляются вследствие взаимодействия электронных переходов с этими колебаниями (электронно-колебательное взаимодействие — ЭКВ) (EMV coupling) [9–12]. Роль такого взаимодействия в электропроводности и появлении сверхпроводимости в органических проводниках, так же как и другие свойства этих материалов, рассмотрены в [13].

Группа изоструктурных солей  $\kappa$ -фазы  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]X (X = Cl, Br, Cl<sub>0.5</sub>Br<sub>0.5</sub>) была впервые представлена в работах [14–17]. Соль с Br является сверхпроводником при нормальном давлении с  $T_c = 11.6$  K; соль с Cl имеет переход в диэлектрическое состояние ниже 50 K и становится сверхпроводником с  $T_c = 12.8$  K под давлением около 0.3 kbar. Соль с  $X = Cl_{0.5}Br_{0.5}$  — сверхпроводник с  $T_c = 11.3$  K. ИК-оптические свойства этих солей представлены в работах [4–8].

Кристаллическая структура солей изучена в [14–18]. Кристаллы относятся к ромбической сингонии, пространственная группа  $P_{nma}$ , Z = 4. Структура состоит из параллельных плоскости (*ac*) слоев катион-радикалов BEDT–TTF<sup>0.5+</sup>, чередующихся вдоль оси *b* со слоями полимерных анионов Cu[N(CN)<sub>2</sub>] $X^-$ . Слои катионрадикалов состоят из димеров (BEDT–TTF)<sub>2</sub><sup>+</sup>, упакованных взаимно перпендикулярно друг другу (*к*-фаза) (вставка на рис. 1).

987

В работе [19] теоретически изучено влияние сильных электронных корреляций для металлической системы с наполовину заполненной зоной проводимости в случае, когда энергия хаббардовского взаимодействия U меньше соответствующей величины, необходимой для перехода в состояние моттовского изолятора. Авторы предполагают, что такая ситуация может иметь место в металлической фазе в молекулярных кристаллах  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>X. В такой системе имеется низкоэнергетическая область, определяемая температурой *T*<sub>0</sub>, которая много меньше полуширины зоны невзаимодействующих электронов (D) и энергии кулоновского отталкивания (U). Величина D имеет порядок энергии Ферми, которая определяется из расчета зонной структуры. В металлической фазе плотность состояний  $\rho(\omega)$ содержит пики при энергиях  $\omega = -U/2$  и +U/2, соответствующие нижней и верхней зонам Хаббарда, в которых имеют место некогерентные возбуждения. Эти пики широкие и имеют ширину порядка D. При температуре меньше  $T_0$  на уровне энергии Ферми в плотности состояний образуется квазичастичный пик шириной T<sub>0</sub>, в котором имеют место когерентные возбуждения. Спектральный вес этого пика исчезает по мере приближения перехода металл-изолятор. Величина То определяет границу, на которой имеется переход к некогерентным возбуждениям.

На основании изложенного выше можно ожидать, что в оптических спектрах возможно проявление двух типов носителей заряда: квазисвободных ("друдевских") электронов (дырок) и локализованных на молекулах носителей заряда. Такое наблюдение было сделано авторами [20] на кристаллах  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl<sub>0.5</sub>Br<sub>0.5</sub> на основании анализа спектров оптической проводимости в приближениях "кластерной" модели для локализованных носителей [21] и теории [22], в которой электроны рассматриваются как свободные носители, движущиеся в периодическом поле.

В работе [23] нами представлены экспериментальные спектры отражения и спектры оптической проводимости соединений  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>x</sub>Cl<sub>1-x</sub> как функции температуры в диапазоне T = 20-300 K и содержания Br x = 0, 0.4, 0.73, 0.85 и 0.9 и проведен их количественный анализ для x = 0.85 в рамках "кластерной" тетрамерной модели [21] с учетом переноса заряда между соседними параллельными молекулами BEDT-TTF, образующими димер (BEDT-TTF)<sup>+</sup><sub>2</sub>.

В настоящей работе изучены процессы переноса заряда в кристаллах  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>x</sub>Cl<sub>1-x</sub> с x = 0.9 (проводник с переходом в сверхпроводящее состояние при T = 11.3 K) и x = 0 (проводник с переходом металл-диэлектрик при T < 50 K) на основании представленных в работе [23] исследований экспериментальных спектров отражения  $R(\omega)$  и спектров оптической проводимости  $\sigma(\omega)$  в широкой спектральной области от 50 до 6000 сm<sup>-1</sup> (6 meV-0.74 eV) в интервале температур 20-300 K (для краткости указанные

соединения будут обозначаться далее как  $\kappa$ -Br (М/СП) и  $\kappa$ -Cl (М/Д) соответственно). Для этой цели нами было предложено комбинированное использование "кластерной" тетрамерной модели [21] с учетом переноса заряда между ближайшими соседними молекулами внутри димера (BEDT-TTF)<sup>+</sup><sub>2</sub> и между соседними ортогональными димерами и модели Друде для свободных носителей заряда.

Ранее в работе [24] проанализирован отклик свободных носителей заряда в низкочастотной части спектра материалов с содержанием Br x = 0.73 и 0.85, при низких температурах (но T > 11.3 K) являющихся металлами, близкими в моттовскому изолятору. Проведено сравнение этих экспериментальных данных с расчетами по теории динамического среднего поля.

# 2. Эксперимент

Поляризованные спектры отражения монокристаллов исследованных соединений в области от 50 до  $6000\,\mathrm{cm}^{-1}$ при температурах от 20 до 300 К были получены с помощью ИК-Фурье-спектрометра Bruker IFS 113v и гелиевого прокачного криостата Конти. Для измерения абсолютных значений отражения использовалась методика, предложенная в работе [25]: после измерения температурной зависимости отражения образца на него in citu напылялась пленка золота толщиной около 100 nm и измерялась температурная зависимость отражения этого эталона. Абсолютные значения отражения при каждой измеренной температуре определялись как отношение R(образца)/R(эталона). Спектры оптической проводимости были получены с помощью соотношений Крамерса-Кронига. При этом использовалась экстраполяция Хагенса-Рубена в низкочастотную область. Для высокочастотной экстраполяции использовались данные о спектрах отражения аналогичных материалов в видимой области [6,7], а на более высоких частотах принималось  $R \sim \omega^{-2}$ .

### 3. Результаты

3.1. Спектры отражения. Ha рис. 1, a-dпредставлены полученные нами ранее в работе [23] спектры отражения  $R(\omega)$  кристаллов  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> сверхпроводника с  $T_c = 11.3$  К (рис. 1, a и b) — и  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl — проводника с переходом металл-диэлектрик при  $T < 50 \,\mathrm{K}$  (рис. 1, *c* и *d*) для наиболее развитой грани кристалла (*ac*), в которой расположены проводящие слои молекул BEDT-TTF, в поляризациях **E** || *a* и **E** || *c* в интервале  $100-5000 \,\mathrm{cm}^{-1}$ при температурах 300, 150, 90, 50 и 20К. На вставке приведена проекция структуры проводящего слоя  $(BEDT-TTF)_{2}^{+}$  на эту грань (см. [18]). Характерные особенности всех представленных спектров, наблюдае-



**Рис. 1.** Спектры отражения кристаллов  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> в поляризациях **E** || a (a) и **E** || c (b) и кристаллов  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl в поляризациях **E** || a (c) и **E** || c (d) при T = 300 (1), 150 (2), 90 (3), 50 (4), 20 K (5). На вставке — структура проводящего слоя (BEDT-TTF)<sub>2</sub> [18].

мые также в [4–11], следующие: 1) широкий максимум, расположенный в ИК-области (1500–3500 сm<sup>-1</sup>), что является существенным отличием спектров данных проводников от присущего металлам "друдевского" ("металлического") вида спектров; 2) интенсивные особенности в области 1500–480 сm<sup>-1</sup>, которые являются следствием взаимодействия электронной системы с  $A_g$ -ВМК (см. раздел 1); 3) различие формы ИК-максимума в поляризациях **Е** || *а* и **Е** || *с* (анизотропия спектров в проводящей плоскости): для **Е** || *а* наблюдается один широкий максимум около 2300 сm<sup>-1</sup>; для **Е** || *с* проявля-

988

ется второй максимум около 3500 сm<sup>-1</sup>, наиболее ярко выраженный при низких температурах.

Рис. 1 показывает, что имеется существенное различие спектров  $R(\omega)$  у двух исследованных кристаллов. Видно, что у  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> в низкочастотной области наблюдается характерное для металлов увеличение отражения при уменьшении частоты, которое ярко выражено при низких температурах. У  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl такого увеличения не наблюдается. В то же время характерный максимум в ИК-области наблюдается у обоих соединений.



**Рис. 2.** Экспериментальные (1) и расчетные (2-4) спектры оптической проводимости  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> в поляризации E || *а* при T = 300 (*a*), 90 (*b*), 50 (*c*) и 20 K (*d*):  $\sigma(\omega)_{exp}$  (1),  $\sigma(\omega)_{Drude}$  (2),  $\sigma(\omega)_{tetra}$  (3),  $\sigma(\omega)_{cryst}$  (4).

3.2. Спектры оптической проводимости. Ha рис. 2, a-d3, a-dпредставлены И оптической проводимости спектры  $\sigma(\omega)$  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> в поляризациях  $\mathbf{E} \parallel a$  и  $\mathbf{E} \parallel c$  при температурах 300, 90, 50 и 20 К. Видно, что указанные особенности спектров отражения проявляются в спектрах  $\sigma(\omega)$  наиболее отчетливо. Для Е || а максимум в ИК-области при указанных температурах находится на частотах 2080, 1880, 1880 и 2000 cm<sup>-1</sup> соответственно, т.е. слегка сдвигается при понижении температуры в сторону низких частот, но затем при 20 К вновь сдвигается к более высокой частоте и сильно уширяется. При 50 и 20 К наблюдается увеличение оптической проводимости при уменьшении частоты в интервале 400-100 cm<sup>-1</sup>, особенно резкое при 20 К. Наиболее интенсивные особенности ЭКВ при 300 К находятся на частотах 1209, 871 и 418 cm<sup>-1</sup> и обусловлены взаимодействием электронов с полно-



**Рис. 3.** Экспериментальные (1) и расчетные (2-4) спектры оптической проводимости  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> в поляризации **E** || *с* при T = 300 (*a*), 90 (*b*), 50 (*c*) и 20 K (*d*). Обозначение кривых то же, что на рис. 2. На вставке — зависимость интеграла перекрывания от дигедрального угла  $\theta$  между плоскостями молекул в структуре  $\kappa$ -фазы [30].

симметричными  $(A_g)$  модами  $\upsilon_2$ ,  $\upsilon_3$ ,  $\upsilon_6$ ,  $\upsilon_7$  и  $\upsilon_{10}$  (для молекулы BEDT-TTF симметрии  $D_{2h}$ ) [12]. Особенность на 1209 сm<sup>-1</sup> имеет резкие провалы на частотах 1272 и 1174 сm<sup>-1</sup>, относящиеся к ЭКВ с модами  $\upsilon_5(A_g)$  и  $\upsilon_{38}(B_{2g})$ , и сдвигается в сторону более высоких частот (на 49–52 сm<sup>-1</sup>) при понижении температуры.

990

Рис. 2 и 3 демонстрируют также анизотропию спектров: для  $\mathbf{E} \parallel a$  наблюдается один широкий максимум в ИК-области около 2080 сm<sup>-1</sup> при 300 K, а для  $\mathbf{E} \parallel c$  проявляются два максимума в этой об-

ласти при  $3200-3300 \text{ cm}^{-1}$  и более размытый в области  $1500-3000 \text{ cm}^{-1}$ , хорошо различимые при T = 150-20 K. Положение этих максимумов слабо зависит от температуры.

На рис. 4, a-d и 5, a-d представлены спектры оптической проводимости  $\sigma(\omega)$   $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl в поляризациях **E** || a и **E** || c при температурах 300, 90, 50 и 20 К. Из рисунков видно, что спектры в общих чертах по положению и форме ИК-максимума, положению и отнесению особенностей ЭКВ, анизотропии



**Рис. 4.** Экспериментальные (1) и расчетные (2–4) спектры оптической проводимости  $\kappa$ -(BEDT–TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl в поляризации **E** || *а* при T = 300 (*a*), 90 (*b*), 50 (*c*) и 20 K (*d*). Обозначение кривых то же, что на рис. 2.

подобны спектрам  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub>. Основное отличие заключается в том, что в этих спектрах не наблюдается увеличения  $\sigma$  с уменьшением частоты при низких частотах и уширения ИК-максимума при 20 К. Имеются также и определенные различия в особенностях ЭКВ, наиболее отчетливо проявляющиеся при низких температурах.

### 4. Обсуждение результатов

4.1. Теоретическая модель. Для описания оптических спектров низкоразмерных молекулярных проводников главным образом используются два альтернативных приближения, учитывающих электронноколебательное взаимодействие: теория "фазовых фононов", предложенная в [22], и "кластерные" модели [26]. Первая теория предполагает, что электроны делокализованы, а электронные корреляции могут быть приняты во внимание только в приближении среднего поля. В кластерном приближении, предложенном для молекулярных проводников  $\kappa$ -фазы в [21], наиболее простая модель проводящего слоя представляет собой два ортогональных димера (BEDT–TTF)<sup>+</sup><sub>2</sub> с двумя дырками на внешних молекулярных орбиталях BEDT–TTF. Модель рассматривает электронные корреляции в приближении Хаббарда и учитывает взаимодействие электронов с внутримолекулярными колебаниями.



**Рис. 5.** Экспериментальные (1) и расчетные (2-4) спектры оптической проводимости  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl в поляризации E || *с* при T = 300 (*a*), 90 (*b*), 50 (*c*) и 20 K (*d*). Обозначение кривых то же, что на рис. 2.

Так как теория "фазовых фононов" написана для одномерного случая и, кроме того, предполагает наличие энергетической щели в спектре электронных возбуждений, для описания делокализованных электронов в настоящей работе мы использовали простую модель Друде:  $\varepsilon = \varepsilon_{\infty} - \omega_p^2/(\omega^2 + i\Gamma_D\omega)$ . Для количественного описания полученных нами спектров  $\sigma(\omega)$  мы использовали комбинацию кластерной теории и модели Друде аналогично тому, как это было сделано нами ранее для описания оптических свойств молекулярного сверхпроводника  $\kappa$ -(BETS)<sub>4</sub>Hg<sub>2.84</sub>Br<sub>8</sub> [27].

992

Принятое нами кластерное приближение описывается уравнением

$$H = H_e + H_V + \sum_{\alpha,i} g_{\alpha,i} n_i Q_{\alpha,i} - \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}, \qquad (1)$$

где первые два члена описывают соответственно электроны (дырки) и внутримолекулярные колебания каждой молекулы в отсутствие ЭКВ, третий член описывает ЭКВ в линейном приближении, где  $g_{\alpha,i}$  обозначает константы ЭКВ электронной плотности дырок  $n_i$  на молекуле i и моды  $\alpha(A_g)$  колебаний этой молеку-

лы с безразмерной координатой  $Q_{\alpha,i}$ . Последний член представляет собой энергию взаимодействия электрического дипольного момента **р** тетрамера, наведенного смещением электронной плотности дырок во внешнем электрическом поле **E**.

Электронный гамильтониан *H<sub>e</sub>* принимается в приближении Хаббарда

$$H_{e} = \frac{U}{2} \sum_{i,\sigma} n_{i,\sigma} n_{i,-\sigma} - t \sum_{\sigma} (c_{1}^{+}c_{2} + c_{3}^{+}c_{4} + \text{h.c.}) - t' \sum_{\sigma} (c_{2}^{+}c_{3} + c_{2}^{+}c_{4} + \text{h.c.}), \qquad (2)$$

где U — энергия кулоновского отталкивания двух электронов (дырок) на одной молекуле, t и t' — интегралы переноса заряда между молекулами внутри димера и между димерами.

Комплексная проводимость кристалла *к*-фазы определяется выражением [28]

$$\sigma_{\text{tetra}}(\omega) = -i\omega N(\mathbf{p}, [\mathbf{I} - \mathbf{X} \cdot \text{diag}\mathbf{D}]^{-1} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{p}), \quad (3)$$
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} e(a+a') \\ ea \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где N — концентрация тетрамеров, a и a' — расстояния между молекулами BEDT—TTF внутри димера и между димерами, I обозначает унитарную матрицу, diagD — диагональная матрица с компонентами

$$D_{i}(\omega) = \sum_{\alpha} \frac{2g_{\alpha,i}^{2}\omega_{\alpha i}}{\omega_{\alpha i}^{2} - \omega^{2} - i\omega\gamma_{\alpha i}},$$
(5)

X обозначает матрицу электронных поляризуемостей с элементами

$$\chi_{ij} = \sum_{\beta} \frac{\langle 1|n_i|\beta\rangle\langle\beta|n_j|1\rangle 2\omega_{\beta 1}}{\omega_{\beta 1}^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma_{\beta}}.$$
 (6)

В равенстве (5)  $\omega_{\alpha i}$  и  $\gamma_{\alpha i}$  — частота и коэффициент затухания  $\alpha$ -моды  $A_g$ -ВМК. В равенстве (6)  $\Gamma_{\beta}$  — феноменологический коэффициент затухания электронного возбуждения с переносом заряда с энергией  $\omega_{\beta 1} = E_{\beta} - E_1; E_{\beta}$ и  $|\beta\rangle$  — собственные величины и собственные функции электронного гамильтониана  $H_e$  в равенстве (1).  $\beta = 1$ обозначает основное состояние. Согласно [29], вклад в  $\sigma(\omega)$  вносят два разрешенных перехода:  $\omega_{21}$  и  $\omega_{51}$ .

Общая проводимость кристалла определялась как сумма оптической проводимости локализованных электронов  $\sigma_{\text{tetra}}$  и сквозной проводимости квазисвободных "друдевских" электронов  $\sigma_{\text{Drude}}$ .

Мы полагаем, что анизотропия экспериментальных спектров  $R(\omega)$  и  $\sigma(\omega)$  в плоскости (ac) может быть обусловлена различной ориентацией молекул BEDT-TTF относительно осей a и c (вставка на рис. 1 [18]) и

зависимостью интегралов перекрывания от дигедрального угла  $\theta$  между плоскостями молекул в структуре к-фазы (вставка на рис. 3 [30]). Поскольку длинная ось молекулы BEDT-TTF наклонена под острым углом к оси  $a ~ (\sim 56^{\circ})$ , мы полагаем, что интеграл перекрывания между соседними ортогональными димерами вдоль оси a больше соответствующего интеграла вдоль оси c, в то время как внутридимерные интегралы перекрывания вдоль осей a и c близки. Поэтому в спектрах  $\sigma(\omega)$  в поляризации Е || с более отчетливо проявляется внутридимерный перенос заряда (хорошо выраженный при низких температурах максимум вблизи 3200-3300 cm<sup>-1</sup>) наряду с переносом заряда между четырьмя молекулами в тетрамере (широкий максимум при 1500-3000 cm<sup>-1</sup>). Можно было бы предположить, что наблюдаемая анизотропия спектров  $\sigma(\omega)$  определяется анизотропией интеграла переноса t'. Однако сделанный нами расчет  $\sigma(\omega)$  с различными значениями t' для  $\mathbf{E} \parallel a$  и  $\mathbf{E} \parallel c$  в большом интервале значений t' не привел к наблюдаемому на опыте (рис. 2 и 3 и рис. 4 и 5) различию  $\sigma(\omega)$  в этих поляризациях. Поэтому на основани приведенной выше анизотропии структуры и интегралов перекрывания мы предположили, что в поляризации Е || с возможно наблюдение как чисто внутридимерных переходов заряда (которые не проявляются в спектрах для  $\mathbf{E} \parallel a$ ), так и тетрамерных переходов, т.е. переходов между четырьмя молекулами. В этом упрощенном предположении общая проводимость кристалла определяется выражениями

$$\sigma_{\text{cryst}}(\omega) = \sigma_{\text{tetra}} + \sigma_{\text{Drude}}, \quad \mathbf{E} \parallel a,$$
 (7)

$$\sigma_{\text{cryst}}(\omega) = (1 - \delta)\sigma_{\text{tetra}} + \delta\sigma_{\text{dimer}} + \sigma_{\text{Drude}} \quad (\delta \le 1), \quad \mathbf{E} \parallel c.$$
(8)

Параметр  $\delta$  определяет долю чисто внутридимерных переходов.

4.2. Сравнение с экспериментом. Полученные расчетные зависимости  $\sigma_{\text{tetra}}(\omega)$ ,  $\sigma_{\text{Drude}}(\omega)$  и общей проводимости кристалла  $\sigma_{\text{cryst}}(\omega)$  (7) и (8) представлены на рис. 2 и 3 для  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> и рис. 4 и 5 для  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl для обеих поляризаций вместе с экспериментальными спектрами  $\sigma_{\text{ехр}}(\omega)$  при T = 300, 90, 50 и 20 К.

Видно, что представленные расчетные (подгоночные) спектры для обеих поляризаций достаточно хорошо описывают экспериментальные спектры — положение и интенсивность ИК-максимума, положение и форму особенностей ЭКВ. (Экспериментальные спектры  $\sigma(\omega)$ при 150 К, не представленные на рисунках, также описываются расчетным спектром.) Показано, что наилучшая подгонка экспериментальных спектров  $\sigma(\omega)$ достигается только при учете суммы параллельных составляющих (7) и (8). Предложенная упрощенная модель объясняет наблюдаемую анизотропию спектров в проводящей плоскости кристаллов (ac). Полученные путем подгонки спектров параметры — величины t, t',  $\Gamma_{\beta}, \omega_{p}, \Gamma_{D}$  — приведены на рис. 6 для  $\kappa$ -Вг (М/СП) (a, b, c) и для  $\kappa$ -Cl (М/Д) (d). Величина U, определенная для молекулы BEDT-TTF в данном приближении,



994

Рис. 6. Физические параметры спектров  $\sigma_{cryst}(\omega)$   $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> при Е || a (a, b), Е || c (c) и  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl при Е || a (d) при температурах 300, 150, 90, 50 и 20 К.

находилась в пределах 2900–2200 сm<sup>-1</sup> (0.36–0.27 eV). Эта величина согласуется со значением, полученным в [23] для кулоновского отталкивания электронов между соседними димерами:  $U_{dimer} = 2000 \text{ cm}^{-1}$ . Из этих рисунков видно, что наблюдаются следующие различия параметров и их изменения с температурой для двух соединений. При подгонке расчетных спектров в поляризации **E** || *c*, в которой отчетливо наблюдается димерный максимум при 3200–3300 сm<sup>-1</sup>, было установлено, что параметр *t* в интервале T = 300-20 K изменяется в пределах 1600–1680 сm<sup>-1</sup> (0.2–0.21 eV), т.е. не больше чем на 5%. Поэтому при подгонке спектров параметр *t* принимался постоянным (t = 0.2 eV) в исследованном интервале *T*. Мы полагаем, что отсутствие димерного

максимума в поляризации  $\mathbf{E} \parallel a$  связано с давыдовским расщеплением, вторая компонента которого ( $\parallel a$ ) попадает в область более интенсивного тетрамерного максимума и поэтому не видна в спектре.

Наиболее существенны следующие наблюдаемые нами закономерности.

4.2.1.  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>0.9</sub>Cl<sub>0.1</sub> (M/CΠ). E || *a* 

1) Наблюдаемая зависимость положения электронного максимума  $\omega_{\text{max}}$  от T коррелирует с зависимостью t'/tот T (рис. 6, *a*). Это указывает на то, что спектр в данной области определяется в значительной степени переносом заряда между ортогональными димерами и подтверждает, по нашему мнению, обоснованность использования "кластерной" тетрамерной модели.

2) Наблюдается слабое уменьшение затухания  $\Gamma_{\beta}$  электронного возбуждения при уменьшении *T* с небольшим минимумом при 150 K (0.21 eV) и резкое возрастание его (до 0.37 eV) при 20 K.

3) Величина  $\omega_p$  квазисвободных ("друдевских") электронов практически не зависит от T, небольшое увеличение  $\omega_p$  наблюдается при 20 К. Затухание "друдевских" электронов  $\Gamma_D$  резко уменьшается при T < 150 К. При 300 и 150 К эти электроны представляют собой сильно затухающую (сильно демпфированную) электронную систему, так как  $\Gamma_D > \omega_p$ , и дают слабую подставку в  $\sigma_{cryst}(\omega)$ . Ниже 150 К наблюдается резкое уменьшение  $\Gamma_D$ , так что при 20 К  $\Gamma_D$  становится много меньше  $\omega_p$  ( $\Gamma_D \ll \omega_p$ ), и наблюдается резкий друдевский пик в  $\sigma_{cryst}(\omega)$  на низких частотах. Эти результаты позволяют связать сильное возрастание затухания  $\Gamma_\beta$  локализованных на кластерах электронов с их взаимодействием с квазисвободыми ("друдевскими") электронами.

4) В табл. 1 приведены константы  $g_{\alpha}$  ЭКВ с полносимметричными внутримолекулярными колебаниями  $A_g$ -ВМК (ЕМV coupling). (При отнесении особенностей ЭКВ в спектрах  $\sigma(\omega)$  нами были использованы данные работы [12] для частот и формы  $A_g$ -ВМК молекулы BEDT-TTF и иона (BEDT-TTF)<sup>+0.5e</sup>). Видно, что наибольшую константу ЭКВ имеет ВМК  $\upsilon_3(A_g)$   $g_3 = 0.092$  eV. При понижении T наблюдается уменьшение констант ЭКВ:  $\upsilon_3(A_g)$  от  $g_3 = 0.092$  eV до  $g_3 = 0.06$  eV и  $\upsilon_7(A_g)$  от  $g_7 = 0.031$  eV до  $g_7 = 0.025$  eV при 300 и при 20 K соответственно. Кроме того, при 20 K несколько изменяется форма особенности ЭКВ  $\upsilon_7(A_g)$ . Другие константы практически не изменяются.



1) В спектрах  $\sigma(\omega)$  в ИК-области наблюдаются два максимума: широкий около 2200 сm<sup>-1</sup>, наблюдаемый в спектре для Е || *а* и отнесенный нами к возбуждениям локализованных электронов в тетрамере, и более узкий максимум при 3200–3300 сm<sup>-1</sup> (см. также в [23]), который, как показано в [21], относится к переходу электрона между молекулами BEDT–TTF в димерах. Из рис. 3 видно, что спектр общей проводимости кристалла  $\sigma_{cryst}(\omega)$  хорошо описывается уравнением (8). Параметр  $\delta = 0.4$ 

 $(10^{-2} \,\mathrm{eV})$  $g_{\alpha}$ 

для

|              | $\upsilon_lpha(A_g)$   |                        |                             |                        | (D) 1174                                     | $\upsilon_{lpha}(A_{g})$  |   |                               |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| <i>Т</i> , К | $v_2 = 1496 \ cm^{-1}$ | $v_3 = 1468 \ cm^{-1}$ | $v_4 = 1370 \ { m cm}^{-1}$ | $v_5 = 1276 \ cm^{-1}$ | $v_{38} (B_{2g}) = 11/4$<br>cm <sup>-1</sup> | $\begin{array}{c} \upsilon_6 = 977 \\ \mathrm{cm}^{-1} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \upsilon_7 = 912 \\ \mathrm{cm}^{-1} \end{array}$ | $v_{10} = 480 \ { m cm}^{-1}$ |
| 300          | 0.6                    | 9.2                    | 1.2                         | 1.0                    | 1.0  | 0.6   | 3.1   | 4.3                           |
| 150          | 1.2                    | 7.4                    | 0.6                         | 1.0                    | 1.0  | 0.25  | 1.4   | 1.9                           |
| 90           | 1.2                    | 6.8                    | 0.5                         | 1.0                    | 0.6  | 0.37  | 1.9   | 3.7                           |
| 50           | 0.7                    | 7.1                    | 0.7                         | 0.87                   | 0.7  | 0.25  | 3.1   | 4.0                           |
| 20           | 0.7                    | 6.2                    | 0.7                         | 0.7                    | 0.87   | 0.25  | 2.5   | 4.2                           |

взаимолействия

\* Отнесение особенностей ЭКВ для молекулы BEDT-TTF симметрии D<sub>2h</sub> [12].

Таблица 2. Константы электронно-колебательного взаимодействия ga (10<sup>-2</sup> eV) для соединения к-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl  $(M/Д) (E \parallel a)^*$ 

|      | $\upsilon_{a}(A_{g})$  |                             |   |   |  | $\upsilon_{lpha}(A_g)$       |                              |                               |
|------|------------------------|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Т, К | $v_2 = 1496 \ cm^{-1}$ | $v_3 = 1468 \ { m cm}^{-1}$ | $\begin{array}{c} \upsilon_4 = 1370 \\ cm^{-1} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \upsilon_5 = 1276\\ \mathrm{cm}^{-1} \end{array}$ | $v_{38} (B_{2g}) = 11/4$<br>cm <sup>-1</sup> | $v_6 = 977$ cm <sup>-1</sup> | $v_7 = 912$ cm <sup>-1</sup> | $v_{10} = 480 \ { m cm}^{-1}$ |
| 300  | 0.6                    | 9.1                         | 1.2   | 1.0   | 0.74   | 0.25                         | 3.2                          | 4.4                           |
| 150  | 1.2                    | 7.4                         | 0.6   | 1.0   | 1.0  | 0.25                         | 3.1                          | 2.4                           |
| 90   | 1.2                    | 6.2                         | 0.5   | 1.9   | 1.0  | 0.37                         | 3.4                          | 4.7                           |
| 50   | 0.6                    | 5.8                         | 0.87  | 1.2   | 1.1  | 0.6                          | 2.7                          | 4.1                           |
| 20   | 0.6                    | 6.6                         | 1.4   | 0.6   | 0.5  | 0.25                         | 3.1                          | 3.9                           |

\* Отнесение особенностей ЭКВ для молекулы BEDT-TTF симметрии D<sub>2h</sub> [12].

при 300 К и увеличивается при понижении температуры до 0.47. Как показывает рис. 6, параметр t слабо увеличивается (в пределах 5%) при понижении Т (как было отмечено выше).

2) При понижении Т постепенно увеличивается вклад "друдевских" электронов: несколько увеличивается  $\omega_p$ , уменьшается затухание  $\Gamma_D$ : при 172 К  $\Gamma_D = \omega_p$ , ниже 172 К  $\Gamma_D < \omega_p$ , электроны становятся квазисвободными, и при 50 и 20 К наблюдается увеличение  $\sigma$  при уменьшении частоты.

3) Константы ЭКВ и их температурные зависимости очень близки к тем, которые определены для поляризации  $\mathbf{E} \parallel a$  (в пределах ошибки определения параметров при подгонке спектров).

4.2.2. *κ*-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Cl (М/Д).  $\mathbf{E} \parallel a$ 

Наблюдались существенные различия в изменении физических параметров при уменьшении температуры у этого кристалла (М/Д) (рис. 6, d) и у сверхпроводника (M/CП) (рис. 6, *a*, *b*).

1) t'/t заметно уменьшается (на 20%) при понижении T (в отличие от сверхпроводника, у которого t'/tувеличивается (на 30%) при уменьшении Т); наблюдается заметное уменьшение затухания  $\Gamma_{\beta}$  (на 50%) электронного тетрамерного перехода; заметно уменьшается вклад "друдевских" электронов (при 50 и 20 К  $\omega_p = 0$ ). Параметр *t* практически не зависит (изменения до 2%) от температуры.

2) Различия в константах ЭКВ (g<sub>a</sub>) и их зависимости от температуры у диэлектрика и сверхпроводника, а следовательно, и влияния "друдевских" электронов на  $g_{\alpha}$ не наблюдалось (табл. 2). Эти факты позволяют заключить, что "друдевские" электроны не взаимодействуют с  $A_g$ -BMK.

 $\mathbf{E} \parallel c$ 

1) При понижении T параметр  $\delta$  уменьшается от 0.49 при 300 К до 0.39 при 20 К; t'/t снижается (на 18%); уменьшаются постоянные затухания Г<sub>в</sub> для димерного и тетрамерного переходов.

2) Константы ЭКВ и их температурные зависимости очень близки к тем, которые определены для поляризации Е || а (табл. 2).

### 5. Заключение

Таким образом, настоящей работе В представлены спектральные оптические исследования органических молекулярных проводников  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu[N(CN)<sub>2</sub>]Br<sub>x</sub>Cl<sub>1-x</sub> c x = 0.9 (cBepxпроводник с  $T_c = 11.3 \text{ K}$ ) и x = 0 (металл с переходом металл/диэлектрик при T < 50 K) при температурах 300, 150, 90, 50 и 20 К. Приведены спектры отражения  $R(\omega)$  и спектры оптической проводимости  $\sigma(\omega)$  в спектральной области  $50-6000 \,\mathrm{cm}^{-1}$  (6 meV $-0.74 \,\mathrm{eV}$ ). Проведен количественный анализ спектров в рамках предложенной авторами модели, предполагающей

соелинения

участие в переносе заряда двух видов носителей локализованных на димерах и тетрамерах молекул BEDT-TTF электронов (дырок) и квазисвободных ("друдевских") носителей заряда. Для этой цели использованы "кластерная" тетрамерная теория, основанная на гамильтониане Хаббарда для сильно коррелированных электронов, и модель Друде для квазисвободных носителей заряда. Определены физические параметры моделей, в том числе энергия кулоновского отталкивания двух электронов (дырок) на одной молекуле U, интегралы переноса между молекулами внутри димера t и между ортогональными димерами t', феноменологическое затухание электронного перехода Г<sub>в</sub>. На основе этой модели дано объяснение природы характерного для молекулярных органических проводников к-фазы ИК-максимума в спектрах  $R(\omega)$  и  $\sigma(\omega)$  и анизотропии спектров в проводящей плоскости молекул BEDT-TTF.

996

Наблюдались существенные различия в изменении физических параметров t'/t и  $\Gamma_{\beta}$  при уменьшении температуры у кристаллов  $\kappa$ -Br (М/СП) и  $\kappa$ -Cl (М/Д). У кристаллов  $\kappa$ -Br наблюдается резкое возрастание  $\Gamma_{\beta}$ при 20 K, что указывает на взаимодействие локализованных на тетрамерах электронов с группой квазисвободных "друдевских" электронов. У кристаллов  $\kappa$ -Cl  $\Gamma_{\beta}$ значительно уменьшается при низких температурах, что свидетельствует о локализации носителей заряда.

Установлено, что константы ЭКВ и их температурные зависимости для соединений к-Вг (М/СП) и к-Сl (М/Д) очень близки, что указывает на то, что с внутримолекулярными колебаниями взаимодействуют только локализованные на кластерах (димерах и тетрамерах) электроны. "Друдевские" электроны с внутримолекулярными колебаниями не взаимодействуют, что свидетельствует о том, что ЭКВ не играет существенной роли в появлении сверхпроводимости в органических проводниках.

Авторы (Р.М.В., В.Н.С. и Б.В.П.) выражают глубокую благодарность В.М. Ярцеву за полезные обсуждения и алгоритм расчетов спектров по кластерной модели.

### Список литературы

- [1] R.H. McKenzie. Science 278, 821 (1997).
- [2] H. Seo, C. Hotta, H. Fukuyama. Chem. Rev. (Washington, D.C.) 104, 5005 (2004).
- [3] M. Dressel, N. Drichko. Chem. Rev. 104, 5689 (2004).
- [4] K. Kornelsen, J.E. Eldridge, H.H. Wang, H.A. Charlier, J.M. Williams. Solid State Commun. 81, 343 (1992).
- [5] J.E. Eldridge, K. Kornelsen, H.H. Wang, J.M. Williams, A.V. Strieby Crouch, D.M. Watkins. Solid State Commun. 79, 583 (1991).
- [6] O.O. Drozdova, V.N. Semkin, R.M. Vlasova, N.D. Kushch, E.B. Yagubskii. Synth. Met. 64, 1, 17 (1994).
- [7] Р.М. Власова, О.О. Дроздова, В.Н. Семкин, Н.Д. Кущ, Э.Б. Ягубский. ФТТ 38, 3, 869 (1996).
- [8] Р.М. Власова, О.О. Дроздова, В.Н. Семкин, Н.Д. Кущ, Е.И. Жиляева, Р.Н. Любовская, Э.Б. Ягубский. ФТТ 41, 897 (1999).

- [9] M.Menegetti, R. Bozio, C. Pecile. J. Phys. (Paris) 47, 1377 (1986).
- [10] M.G. Kaplunov, E.B. Yagubskii, L.P. Rosenberg, Yu.G. Borodko. Phys. Status Solidi A 89, 509 (1985).
- [11] M.G. Kaplunov, R.N. Lyubovkaya, M.Z. Aldoshina, Yu.G. Borodko. Phys. Status Solidi A 104, 833 (1987).
- [12] J.E. Eldridge, Y. Xie, Hau H. Wang, J.M. Williams, A.M. Kini, J.A. Schlueter. Spectrochim. Acta A 52, 45 (1996); A 51, 947 (1995).
- [13] T. Ishiguro, K. Yamaji. Organic Superconductors. Springer Series in Solid-State Sciences. Springer-Verlag (1990). P. 88.
- [14] A.M. Kini, U. Geiser, H.H. Wang, K.D. Carlson, J.M. Williams, W.K. Kwok, K.G. Vandervoort, J.E. Thompson, D. Stupka, D. Jung, M.-H. Whngbo. Inorg. Chem. 29, 2555 (1990).
- [15] H.H. Wang, A.M. Kini, L.K. Montgomery, U. Geiser, K.D. Karlson, J.M. Willias, J.E. Thompson, D.M. Watkins, W.K. Kwok. Chem. Mater. 2, 482 (1990).
- [16] J.M. Williams, A.M. Kini, H.H. Wang, K.D. Carlson, U. Geiser, L.K. Montgomery, G.J. Pyrka, D.M. Watkins, L.M. Kommers, S.J. Boryschuk, A.V. Strieby Crouch, W.K. Kwok, J.E. Schirber, D.L. Overmyer, D. Jung, M.-H. Whangbo. Inorg. Chem. 29, 3272 (1990).
- [17] N.D. Kushch, L.I. Buravov, A.G. Khomenko, E.B. Yagubskii, L.D. Rozenberg, R.P. Shibaeva. Synth. Met. 53, 155 (1993).
- [18] U. Geiser, A. Schultz, H.H. Wang, D.M. Watkins, D.L. Stupka, J.M. Williams, J.E. Schirber, D.L. Overmyer, D. Jung, J.J. Novoa, M.-H. Whagbo. Physica C 174, 475 (1991).
- [19] J. Merino, R.H. McKenzie. Phys. Rev. B 61, 12, 7696 (2000).
- [20] B.V. Petrov, V.N. Semkin, R.M. Vlasova, V.M. Yartsev, N.D. Kushch, A. Graja. NATO Science Series. V. 59. / Eds. A. Graja, B.R. Bulka, F. Kajzar (2001). P. 259.
- [21] V.M. Yartsev, O.O. Drozdova, V.N. Semkin, R.M. Vlasova. J. Phys. I (France) 6, 1673 (1996).
- [22] M.J. Rice. Phys. Rev. Lett. 37, 1, 36 (1976).
- [23] D. Faltermeier, J. Barz, M. Dumm, M. Dressel, N. Drichko, B. Petrov, V. Semkin, R. Vlasova, C. Meziere, P. Batail. Phys. Rev. B 76, 165 113 (2007).
- [24] J. Merino, M. Dumm, N. Drichko, M. Dressel, R.H. McKenzie. Phys. Rev. Lett. 100, 086 404 (2008).
- [25] C.C. Homes, M. Reedyk, D.A. Cradles, T. Timusk. Appl. Opt. 32, 2976 (1993).
- [26] V.M. Yartsev. Springer proc. in physics. V. 81. Material and measurements in molecular electronics / Eds K. Kajimura, S. Kuroda. Springer-Verlag, Tokyo (1996). P. 189.
- [27] Р.М. Власова, Н.В. Дричко, Б.В. Петров, В.Н. Семкин, Е.И. Жиляева, Р.Н. Любовская, I. Olejniczak, A. Kobayashi, Н. Kobayashi. ФТТ 46, 11, 1921 (2004).
- [28] P. Delhaes, V.M. Yartsev. In: Spectroscopy of new materials / Eds R.J.H. Clark, R.E. Hester. Wiley, Chichester (1993). P. 199.
- [29] V.M. Yartsev, O.O. Drosdova, V.N. Semkin, R.M. Vlasova, R.N. Lyubovskaya. Phys. Status Solidi B 209, 471 (1998).
- [30] T. Mori, H. Mori, S. Tanaka. Bull. Chem. Soc. Jpn. 72, 179 (1999).